

**ПРОГРАММА РАСЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА СХЕМ
С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ДИОДАМИ И ТРИОДАМИ**

В. В. ФЕНИНГ

(Представлена научным семинаром кафедры радиотехники)

Рассматриваемая программа составлена на языке АЛГОЛ-60 (транслятор «МЭИ-2») для ЭЦВМ «Минск-2». Для анализа установившегося режима используется метод разбиения схемы на линейную и нелинейную части [1]. Линейная часть схемы представляется в виде многополюсника (точнее, $2n$ -полюсника), входами которого являются ветви нелинейных элементов. Диоду соответствует одна нелинейная ветвь, триоду — две. Для линейного многополюсника может быть записано уравнение:

$$Y = HX + F \begin{bmatrix} I \\ E \end{bmatrix}, \quad (1)$$

где X и Y — n -мерные векторы, составленные из токов и напряжений внешних ветвей: если i -тым элементом вектора X является ток соответствующей ветви, то i -тым элементом вектора Y является напряжение этой же ветви и наоборот:

n — число внешних ветвей;

H — квадратная матрица размером $n \times n$;

F — прямоугольная матрица размером $n \times s$ (s — число независимых источников);

I и E — соответственно векторы независимых источников тока и источников напряжения.

Векторы X и Y находятся при совместном решении методом Ньютона уравнения (1) и уравнений нелинейных элементов

$$Y = f_1(X). \quad (2)$$

где f — n -мерный вектор-функция. Если решение производить относительно вектора X , то получим следующую схему счета [2]

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - W^{-1}(X^{(k)}) f(X^{(k)}), \quad (3)$$

где

$$f(X^{(k)}) = HX^{(k)} + F \begin{bmatrix} I \\ E \end{bmatrix} - f_1(X^{(k)});$$

$$W(X^{(k)}) = H - f_1'(X^{(k)}),$$

$W(X^{(k)})$ и $f_1'(X^{(k)})$ — матрицы Якоби соответственно для функций $f(X)$ и $f_1(X)$.

Сходимость метода последовательных приближений при решении по формуле (3) тем лучше, чем меньше норма матрицы $W(X)$ [2], а, следовательно, и норма матрицы $f'_1(X)$. Если все нелинейные ветви являются двухполюсными элементами (в нашем случае полупроводниковыми диодами), то матрица $f'_1(X)$ является диагональной, каждый элемент которой равен динамической проводимости соответствующего элемента — если в вектор X входит напряжение этого элемента, либо динамическому сопротивлению — если в вектор X входит ток. Таким образом, для улучшения сходимости у полупроводниковых диодов, смещенных в обратном направлении (обладающих малой проводимостью), необходимо включать в вектор X напряжения, а у диодов, смещенных в прямом направлении (обладающих малым сопротивлением), необходимо включать в вектор X ток.

Для полупроводникового триода, который в настоящей программе представляется двумя нелинейными ветвями эмиттер-база и коллектор-база, в матрицу $f'_1(X)$ входят четыре элемента: $\frac{\partial u_3}{\partial x_3}$, $\frac{\partial u_3}{\partial x_k}$,

$\frac{\partial u_k}{\partial x_3}$ и $\frac{\partial u_k}{\partial x_k}$. Расчеты показывают, что наименьшие значения этих параметров получаются также при условии, когда для переходов, смещенных в прямом направлении, в вектор X включаются токи, а для обратно смещенных переходов — напряжения.

В работе [3] доказывается, что группировка токов и напряжений внешних ветвей в векторы X и Y определяется выбором дерева графа схемы. Может быть показано, что для существования матриц H и F уравнения (1) при выбранном группировании переменных в векторы X и Y необходимо, чтобы каждая токовая переменная вектора X и каждый внутренний источник тока соответствовал связи, а каждая переменная напряжения в X и внутренний источник ЭДС — ветви дерева.

В настоящей программе реализован алгоритм выбора дерева из условия обеспечения наилучшей сходимости в соответствии с приведенными выше рекомендациями: ветви с малыми проводимостями включаются в ветви дерева, а с малыми сопротивлениями — в связи. Режим работы нелинейных элементов определяется по заданному исходному решению. Основой подпрограммы формирования дерева схемы является процедура добавления к частному дереву (которое может состоять из нескольких поддеревьев) одной ветви.

Если оба узла анализируемой ветви уже входят в одно из поддеревьев, либо эти узлы тождественны, то ветвь является связью. Во всех остальных случаях ветвь добавляется к дереву. При этом возможны следующие ситуации:

— оба узла не входят в одно из поддеревьев — ветвь образует новое поддерево;

— один из узлов входит в i -тое поддерево, второй не входит ни в одно из поддеревьев — ветвь добавляется к i -тому поддереву;

— один из узлов входит в i -тое поддерево, второй в j -тое; при этом производится объединение i -ого и j -го поддеревьев.

Построение дерева начинается с источников ЭДС. Далее к дереву добавляются ветви переходов полупроводниковых приборов, смещенных в обратном направлении, затем резисторы. Таким образом, если может быть выбрано дерево, включающее все источники ЭДС, ветви нелинейных элементов с малыми проводимостями и часть резисторов, то оно после этого этапа уже будет построено. Далее дерево достраивается (при необходимости) ветвями переходов полупроводниковых приборов, смещенных в прямом направлении.

Для получения матриц линейной части схемы H и F используются матрицы основных контуров (Γ) и контурных сопротивлений (Z).

В работе [3] приведен вывод выражений для вычисления матрицы H для случая, когда внутри линейного многополюсника оставляются лишь пассивные элементы. В рассматриваемом методе многополюсник содержит также независимые источники напряжения и источники тока. Применяя для обозначения совокупности независимых источников тока многополюсника индекс MI , для пассивных связей — RC , для токовых входов (внешние ветви, у которых в вектор X входит ток) — NC , для независимых источников напряжения — ME для пассивных ветвей дерева — RB и для напряженческих входов (в вектор X входит напряжение ветви) — NB , произведем разделение матриц Γ , Z , H , F следующим образом:

$$\Gamma = \begin{matrix} & MI & RC & NC & ME & RB & NB \\ MI & \left[\begin{array}{cccccc} E_1 & 0 & 0 & \Gamma_1 & \Gamma_2 & \Gamma_3 \\ 0 & E_2 & 0 & \Gamma_4 & \Gamma_5 & \Gamma_6 \\ 0 & 0 & E_3 & \Gamma_7 & \Gamma_8 & \Gamma_9 \end{array} \right] & & & & & \\ RC & & & & & & \\ NC & & & & & & \end{matrix}; \quad Z = \begin{matrix} & MI & RC & NC \\ MI & \left[\begin{array}{ccc} Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{array} \right] & & \\ RC & & & \\ NC & & & \end{matrix};$$

$$H = \begin{matrix} & NC & NB \\ NC & \left[\begin{array}{cc} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{array} \right] & \\ NB & & \end{matrix}; \quad F = \begin{matrix} & MI & ME \\ MI & \left[\begin{array}{cc} F_{11} & F_{12} \\ F_{21} & F_{22} \end{array} \right] & \\ ME & & \end{matrix}.$$

Применяя уравнения метода контурных токов, после некоторых преобразований могут быть получены следующие напряжения, которые используются в настоящей программе для вычисления элементов матриц H и F :

$$\begin{aligned} H_{11} &= Z_{32}Z_{22}^{-1}Z_{23} - Z_{33}; & H_{12} &= Z_{32}Z_{22}^{-1}\Gamma_6 - \Gamma_9; \\ H_{21} &= \Gamma_9^t - \Gamma_6^tZ_{22}^{-1}Z_{23}; & H_{22} &= -\Gamma_6^tZ_{22}^{-1}\Gamma_6; \\ F_{11} &= Z_{32}Z_{22}^{-1}Z_{21} - Z_{31}; & F_{12} &= \Gamma_7 - Z_{32}Z_{22}^{-1}\Gamma_4; \\ F_{21} &= \Gamma_3^t - \Gamma_6^tZ_{22}^{-1}Z_{21}; & F_{22} &= \Gamma_6^tZ_{22}^{-1}\Gamma_4, \end{aligned}$$

где t — символ транспонирования.

Приведенный выше метод расчета обеспечивает хорошую сходимость метода Ньютона в том случае, когда область работы полупроводниковых элементов совпадает с заданным исходным режимом. Однако иногда неизвестен (неправильно задан) режим работы нелинейных элементов или невозможно выбрать дерево, обеспечивающее наилучшую сходимость. Поэтому в программе введена модификация метода Ньютона, которая рассматривается ниже.

Отметим, что определение методом Ньютона на каждом шаге вектора $X^{(k+1)}$ по формуле (3) эквивалентно расчету приближающей схемы, полученной из исходной путем замены нелинейных элементов линейными динамическими сопротивлениями (проводимостями) и источниками ЭДС (тока). Линеаризация проводится при значении вектора X , полученного на предыдущем шаге.

Таким образом, учитывая полученный ранее вывод, видим, что сходимость улучшается в том случае, если для ветвей с малой проводимостью линеаризация осуществляется при заданном напряжении ($X^{(k)} = U^{(k)}$), а с малым сопротивлением — при заданном токе ($X^{(k)} = i^{(k)}$).

Можно заметить, что тот же результат, который достигается группировкой токов и напряжений нелинейных ветвей в векторы X и Y , соответствующей лучшей сходимости метода Ньютона, может быть получен следующим образом: на каждом k -том шаге определяются токи и напряжения всех нелинейных ветвей (т. е. в нашем случае после на-

хождения вектора $X^{(k)}$ из линейной системы определяется вектор $Y^{(k)}$ линеаризация характеристик нелинейных элементов на $(k + 1)$ -ом шаге проводится либо при значении напряжения $U^{(k)}$ (переход смещен в обратном направлении), либо при значении тока $i^{(k)}$ (переход смещен в прямом направлении).

ЛИТЕРАТУРА

1. В. М. Бондаренко. Вопросы анализа нелинейных электрических и электронных цепей. Изд. «Наукова думка». Киев, 1967.
 2. В. П. Демидович и И. А. Марон. Основы вычислительной математики, Изд. «Наука», М., 1966.
 3. H. C. So. On the hybrid description of a linear n-port resulting from the extraction of the arbitrarily specified elements, IEEE Trans. on Circuit Theory, vol. CT-12, pp. 381—387, Sept. 1965.
-